

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成22年4月15日(2010.4.15)

【公開番号】特開2008-266771(P2008-266771A)

【公開日】平成20年11月6日(2008.11.6)

【年通号数】公開・登録公報2008-044

【出願番号】特願2007-229788(P2007-229788)

【国際特許分類】

C 2 3 C	14/08	(2006.01)
H 0 1 L	41/09	(2006.01)
H 0 1 L	41/18	(2006.01)
H 0 1 L	41/24	(2006.01)
H 0 1 L	41/22	(2006.01)
H 0 1 L	21/8246	(2006.01)
H 0 1 L	27/105	(2006.01)
H 0 1 L	21/316	(2006.01)
C 2 3 C	14/34	(2006.01)
B 4 1 J	2/045	(2006.01)
B 4 1 J	2/055	(2006.01)
B 4 1 J	2/16	(2006.01)

【F I】

C 2 3 C	14/08	K
H 0 1 L	41/08	C
H 0 1 L	41/08	L
H 0 1 L	41/18	1 0 1 Z
H 0 1 L	41/22	A
H 0 1 L	41/22	Z
H 0 1 L	27/10	4 4 4 C
H 0 1 L	41/22	B
H 0 1 L	21/316	Y
C 2 3 C	14/34	N
B 4 1 J	3/04	1 0 3 A
B 4 1 J	3/04	1 0 3 H

【手続補正書】

【提出日】平成22年3月2日(2010.3.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板上に下記式(P)で表されるペロブスカイト型酸化物を含む強誘電体膜を成膜する方法であつて、

成膜温度 T s () と、

成膜時のプラズマ中のプラズマ電位 V s (V) とが、下記式(1)及び(2)を充足する成膜条件で、スパッタ法により成膜することを特徴とする強誘電体膜の成膜方法。

A₁ + [(Z r_x T i_{1-x})_{1-y} M_y] O_z . . . (P)

(式中、AはAサイト元素であり、Pbを主成分とする少なくとも1種の元素である。Zr, Ti, 及びMはBサイト元素である。MはV, Nb, Ta, 及びSbからなる群より選ばれた少なくとも1種の元素である。

$0 < x \leq 0.7, 0.1 \leq y \leq 0.4$ 。

=0及びz=3が標準であるが、これらの値はペロブスカイト構造を取り得る範囲内で基準値からずれてもよい。)

$$\begin{array}{l} 400 \text{ Ts() } 475 \dots (1) \\ 20 \text{ Vs(V) } 50 \dots \dots (2) \end{array}$$

【請求項2】

基板上に下記式(P)で表されるペロブスカイト型酸化物を含む強誘電体膜を成膜する方法であって、

成膜温度Ts()と、

成膜時のプラズマ中のプラズマ電位Vs(V)とが、下記式(3)及び(4)を充足する成膜条件で、スパッタ法により成膜することを特徴とする強誘電体膜の成膜方法。

$A_{1+x}[(Zr_xTi_{1-x})_{1-y}M_y]O_z \dots (P)$

(式中、AはAサイト元素であり、Pbを主成分とする少なくとも1種の元素である。

Zr, Ti, 及びMはBサイト元素である。MはV, Nb, Ta, 及びSbからなる群より選ばれた少なくとも1種の元素である。

$0 < x \leq 0.7, 0.1 \leq y \leq 0.4$ 。

=0及びz=3が標準であるが、これらの値はペロブスカイト構造を取り得る範囲内で基準値からずれてもよい。)

$$\begin{array}{l} 475 \text{ Ts() } 600 \dots (3) \\ Vs(V) \quad 40 \dots \dots \dots (4) \end{array}$$

【請求項3】

前記強誘電体膜がSiを実質的に含まないことを特徴とする請求項1又は2に記載の強誘電体膜の成膜方法。

【請求項4】

式(P)中のxが $0 < x \leq 0.2$ の範囲内にあることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の強誘電体膜の成膜方法。

【請求項5】

式(P)中のyが $0.2 \leq y \leq 0.4$ の範囲内にあることを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の強誘電体膜の成膜方法。

【請求項6】

式(P)中のAがBiを含むことを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載の強誘電体膜の成膜方法。

【請求項7】

請求項1~6のいずれかに記載の強誘電体膜の成膜方法によって成膜されたことを特徴とする強誘電体膜。

【請求項8】

多数の柱状結晶からなる膜構造を有することを特徴とする請求項7に記載の強誘電体膜。

【請求項9】

3.0 μm以上の膜厚を有することを特徴とする請求項7又は8に記載の強誘電体膜。

【請求項10】

請求項7~9のいずれかに記載の強誘電体膜と、該強誘電体膜に対して電界を印加する電極とを備えたことを特徴とする強誘電体素子。

【請求項11】

請求項10に記載の強誘電体素子からなる圧電素子と、

液体が貯留される液体貯留室及び該液体貯留室から外部に前記液体が吐出される液体吐

出口を有する液体貯留吐出部材とを備えたことを特徴とする液体吐出装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0027

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0027】

焼結助剤やアクセプタイオニによって強誘電性能が低下することが知られている。本発明では焼結助剤やアクセプタイオニを必須としないので、焼結助剤やアクセプタイオニによる強誘電性能の低下が抑制され、ドナイオニの添加による強誘電性能の向上が最大限引き出される。なお、本発明では、焼結助剤やアクセプタイオニを必須としないが、特性に支障のない限り、これらを添加することは差し支えない。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0049

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0049】

$V_s - V_f$ が基板 B に衝突するターゲット T の構成元素 T p の運動エネルギーに相關することを述べた。下記式に示すように、一般に運動エネルギー E は温度 T の関数で表されるので、基板 B に対して、 $V_s - V_f$ は温度と同様の効果を持つと考えられる。

$$E = 1/2 m v^2 = 3/2 k T$$

(式中、m は質量、v は速度、k はボルツマン定数、T は絶対温度である。)

$V_s - V_f$ は、温度と同様の効果以外にも、表面マイグレーションの促進効果、弱結合部分のエッチング効果などの効果を持つと考えられる。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0055

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0055】

本発明者は、上記一般式 (P) で表されるペロブスカイト型酸化物からなる圧電膜を成膜する場合、成膜温度 T_s () = 約 420 の条件では、 V_s (V) = 約 48 とすることで、P b 抜けのないペロブスカイト結晶を成長させることができるが、得られる膜の圧電定数 d_{31} は 100 pm/V 程度と低いことを見出している。この条件では、 V_s 、すなわち基板に衝突するターゲット T の構成元素 T p のエネルギーが高すぎるために、膜に欠陥が生じやすく、圧電定数が低下すると考えられる。本発明者は、上記式 (1) 及び (1-1)、又は (3) 及び (1-2) を充足する範囲で成膜条件を決定することで、圧電定数 d_{31} 130 pm/V の圧電膜を成膜できることを見出している。